

УДК 535.215.12:537.226.33

©1994

МОДЕЛЬ АНИЗОТРОПНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА В LiNbO_3

И.Ф.Канаев, Н.В.Суровцев

Рассматривается индуцированное рассеяние света, индикаториса которого вытянута в направлениях, параллельных оптической оси (z) в LiNbO_3 . Этот вид рассеяния не объясняется в популярной модели голограмического усиления исходного шума. Показано, что рассеяние обусловлено наведенными неоднородностями показателя преломления. Пространственные формы последних оказываются вытянутыми в направлениях, перпендикулярных z .

При прохождении лазерного пучка через сегнетоэлектрический кристалл LiNbO_3 возникает сильное фотоиндуцированное рассеяние света (ФИРС). В популярных моделях ФИРС связывается со стационарным голограмическим усилением исходного фона рассеяния. Однако такая идея приемлема только для случая нелокального отклика среды на воздействие света [1]. При локальном отклике, что установлено для LiNbO_3 , в ряде случаев коэффициент голограмического усиления в стационарном состоянии обращается в нуль. Возникновение стационарного рассеяния при локальном отклике объясняется в работе [2] (динамическая модель). В этой работе рассеяние связывается с индуцированными нестационарными неоднородностями показателя преломления Δn . Свет, рассеянный каждой неоднородностью, претерпевает нестационарное голограмическое усиление.

В настоящей работе предлагается дальнейшая разработка динамической модели ФИРС. Исследуется случай наиболее интенсивного для LiNbO_3 вида рассеяния без поворота поляризации. Экспериментально установлено, что коэффициент голограмического усиления не превышает 10. Эта величина в моделях стационарного голограмического усиления исходного голограмического шума должна быть порядка $10^4 - 10^6$.

1. Эксперимент

Опыты проведены на образце Y-среза $\text{LiNb}_3:\text{Fe}$ (0.1 вес.%, в дальнейшем Fe-образец) толщиной $h = 0.6$ мм и образце $\text{LiNbO}_3:\text{Cu}$ (0.1 вес.%, Cu-образец), $h = 1$ мм. Образцы помещались в кювету с водой, чтобы избежать поверхностных электрических пробоев, вносящих в измерения нестабильность. Облучение проводилось параллельно оси Y лучом аргонового лазера ($\lambda = 0.514$ мкм). Интенсивность входящего

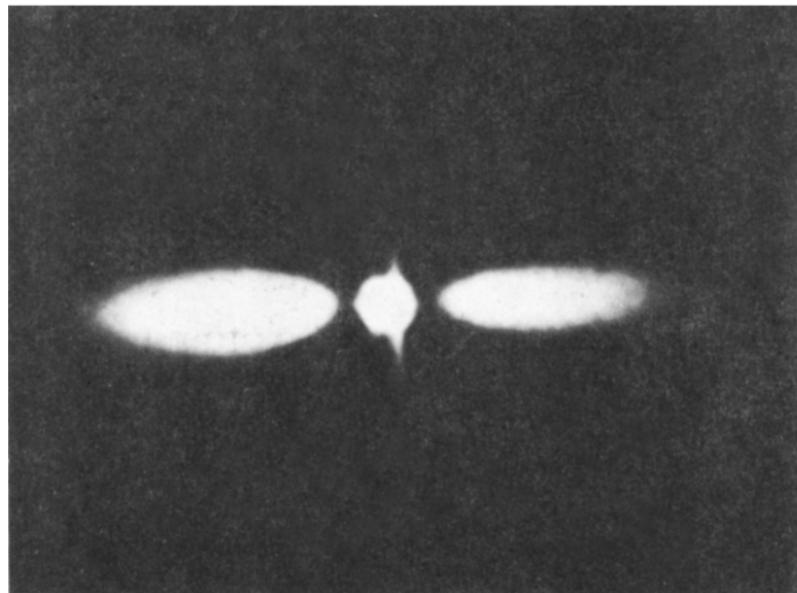


Рис. 1. Стационарное рассеяние e -луча.

в образец пучка $10 \text{ Вт}/\text{см}^2$, освещаемая площадь 2 мм^2 . Некоторые характеристики ФИРС и голографической записи на исследуемых образцах имеются в [2,3].

В данной работе исследовалось рассеяние обычного (σ) и необыкновенного (ϵ) лучей без поворота поляризации. Наиболее интенсивным является рассеяние, индикатором которого вытянута в направлениях, близких к z . Будем обозначать это рассеяние для σ -луча $\sigma-\sigma(\parallel Z)$, для e -луча $e-e(\parallel Z)$.

Характерный вид рассеяния e -луча, проходящего через образец $\text{LiNbO}_3:\text{Си}$, представлен на рис. 1. В этом опыте интенсивность проходящего пучка уменьшилась по отношению к исходной на 90%. Из них 60% ушло в рассеяние $e-e(\parallel Z)$. В Fe-образце этот вид рассеяния наиболее активен — в него уходит не менее 95% мощности пучка. Зависимость распределения интенсивности по круговому сечению от угла с осью Z в Си-образце представлена на рис. 2 (угол с направлением облучающего пучка равен 8°).

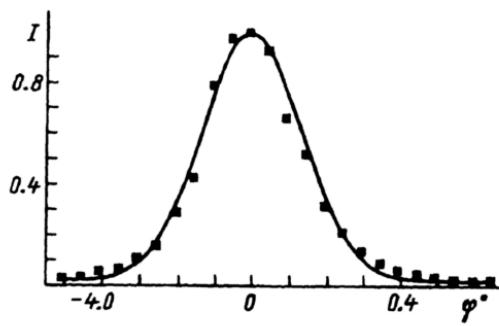


Рис. 2. Угловое распределение рассеяния.
Точки — экспериментальные данные.

При облучении о-лучом стационарное рассеяние в Си-образце слабое. В Fe-образце рассеяние о-о($\parallel Z$) активно и имеет особенность: в отличие от $e-e(\parallel Z)$ оно вытянуто вдоль прямой, имеющей с осью Z некоторый угол. Величина этого угла, по данным работ [2,4], составляет примерно $15-18^\circ$. Наши измерения распределения интенсивностей показывают, что угол между максимумами рассеяний о-о($\parallel Z$) и $e-e(\parallel Z)$ составляет $10-12^\circ$.

При изменении направления облучения, как известно, должно нарушиться условие Брэгга для голографических решеток, записанных при взаимодействии основного пучка с рассеянными. После изменения направления основной пучок будет испытывать рассеяние без голографического усиления. В опытах измерения проводились за времена, которые значительно меньше времен записи новых неоднородностей и решеток. Начиная с угла $\alpha \gtrsim 4^\circ$ интенсивность рассеяния прекращала уменьшаться и достигала постоянной величины. Отношение интенсивностей рассеяния при $\alpha = 0^\circ$ и $\alpha \gtrsim 4^\circ$ мы будем называть голографическим усилением. Оно в области максимума интенсивности варьировалось в разных опытах от 7 до 13.

Была использована другая возможность выяснить фотоиндуцированное рассеивающее действие облученной области. Она заключалась в использовании для зондирования слабого луча гелий-неонового лазера ($\lambda = 0.63$ мкм), который не удовлетворяет условию Брэгга для шумовых голограмм, записанных при $\lambda = 0.514$ мкм. Наблюдаемая индикаторика рассеяния зондирующего луча аналогична рассеянию луча аргонового лазера. Она тоже вытянута вдоль Z .

Существование 10%-ного рассеяния не может быть объяснено дифракцией на голограммах, записанных пучками рассеяния. Для этого каждый пучок рассеяния должен иметь интенсивность порядка 10% от основного. Это видно из соотношений экспериментальных

$$\eta_{pp} I_0 / \eta_{0p} I_0 \simeq 10^{-1}$$

и оценочных из формулы Когельника

$$\eta_{0p} \sim I_0 I_p, \quad \eta_{pp} \sim I_p I_p.$$

Следовательно,

$$I_p / I_0 = \eta_{pp} / \eta_{0p} \simeq 10^{-1},$$

здесь I_0 , I_p — интенсивности пучков основного и рассеянного; η_{0p} , η_{pp} — дифракционная эффективность решеток, записанных соответственно пучками основным, рассеянным и рассеянными.

Существование рассеяния в отсутствие голографического усиления позволяет предположить, что в процессе облучения наводятся центры рассеяния. Для создания рассеяния, вытянутого вдоль Z , эти центры должны быть анизотропными. Согласно предположениям [2], центры возникают за счет шумовой интерференции. Мы исследовали под микроскопом распределение интенсивности облучающего пучка на выходной грани кристалла. В начальный момент облучения интенсивность однородна. С течением времени появляются яркие максимумы и практически стопроцентные минимумы, вытянутые в среднем поперек

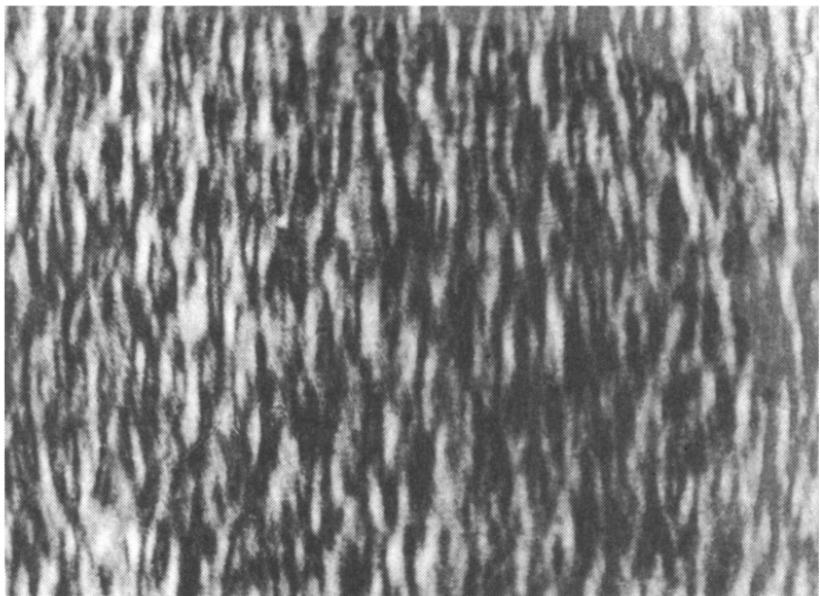


Рис. 3. Микрофотография распределения интенсивности.

оси Z . В равновесном состоянии (рис. 3) они испытывают плавную (с максвелловским временем) перестройку без существенных изменений картины распределения. Средний размер световых неоднородностей в направлениях, параллельных Z , составляет ~ 2 мкм. Подчеркнем, что аналогичная структура только с меньшим контрастом наблюдается в облученном кристалле и в белом свете.

2. Модель

При облучении кристалла, кроме основного пучка, имеются слабые дополнительные пучки рассеяния. В результате многолучевой интерференции распределение света становится неоднородным. Математически многолучевая интерференция описывается суммой или, как часто выражаются, набором решеток $E_i E_j e^{ik_{ij} \tau}$. В местах пересечения максимумов многих решеток интенсивность может оказаться значительно выше средней, она пропорциональна IN^2 (N — число пучков с интенсивностью I). Связь Δn с интенсивностью в LiNbO_3 нелинейна во времени $\Delta n \sim (-t/\tau)$, где τ — характерное максвелловское время $\tau \sim I^{-1}$. Вследствие последних двух факторов на каком-то этапе времени облучения Δn не может быть выражена через решетки, заданные исходными световыми пучками. Для описания необходимо ввести дополнительные, в общем случае хаотически распределенные, образования Δn , которые будут являться центрами рассеяния. Эти центры приводят к изменению распределения интенсивности и соответственно к новому набору световых решеток. В нелинейности записи этих решеток будет уже сказываться наличие фона Δn , наведенного предыдущим облучением. Если связь между Δn и I не испытывает насыщения (например, $\Delta n \sim I$) и имеется обратная связь (пояснение о которой будет дано ниже), то процесс перестройки в распределениях Δn и I может

длиться бесконечно. Это краткая аннотация модели ФИСР, предлагаемой в работе [2].

Выше было приведено дополнительное подтверждение модели: прямое наблюдение показывает, что в процессе облучения возникают мигрирующие световые максимумы и минимумы. Ниже мы более подробно, чем в [2], обсудим связь распределения интенсивности рассеяния с параметрами, определяющими процесс фоторефракции.

Рассеяние в стационарном состоянии, как можно понять из [2], является результатом установления самосогласованного или самоподдерживающегося режима: распределения Δn и I воспроизводят друг друга. Однозначного, точного воспроизведения быть не может, так как прямая $\Delta n(I)$ и обратная $I(\Delta n)$ связи управляются разными физическими законами. Первая определяется механизмами записи, вторая — законами оптики. Воспроизводится только общий характер структур распределений.

Почти все свойства, определяющие фоторефракцию, анизотропны. Анизотропными, например, являются световые фигуры многолучевой интерференции. Среди них имеются и вытянутые в относительно разных направлениях формы. За счет анизотропного механизма записи в Δn отобразятся фигуры определенных направлений. Индуцированные с таким выбором центры Δn подкорректируют направления вытянутости фигур интерференции. Проиллюстрируем это предположение.

Для примера рассмотрим центры Δn в виде цилиндров. Пусть они расположены в плоскости XZ и их оси ориентированы вдоль направления X . Основная волна, распространяющаяся вдоль Y , будет рассеиваться на них в направлениях, лежащих в плоскости YZ , перпендикулярной образующим цилиндров. Максимумы интенсивности интерференции в данном случае имеют цилиндрические формы, ориентированные вдоль X . При наличии углового разброса направлений расположения цилиндров относительно X такой же угловой разброс относительно Z будет иметь место в распределении рассеяния.

На рис. 4 приведен результат машинного расчета распределения интенсивности при интерференции 11 лучей. Направления лучей выбраны так, чтобы они расположились в пределах экспериментально наблюдаемого рассеяния. Темные и светлые области показывают интенсивность выше и соответственно ниже определенного уровня. На рис. 4, a, b показаны распределения в плоскости, параллельной (YZ) и перпендикулярной (XZ) основному лучу. Видно, что световые фигуры интерференции, так же как и предшлагаемые рассеиватели, вытянуты в направлениях, близких к X . Подчеркнем, что результаты машинного расчета (рис. 4, b) по внешнему виду похожи на экспериментально наблюдавшую под микроскопом картину распределения интенсивности. В рассматриваемом случае возможна реализация механизма самоподдержания — рассеяние на вытянутых центрах Δn , ориентированных в каком-либо направлении, приводит к созданию также ориентированных максимумов интенсивности света и, следовательно, максимумов Δn .

Рассмотрим стационарную картину рассеяния, подразумевая под голографическим усилением его усредненное по времени значение. Для упрощения будем рассматривать рассеяние в виде распределения $N(y, \theta, \varphi)$ пучков с фиксированной интенсивностью i (здесь θ — угол между рассеянной и основной волной, φ — угол между проекцией

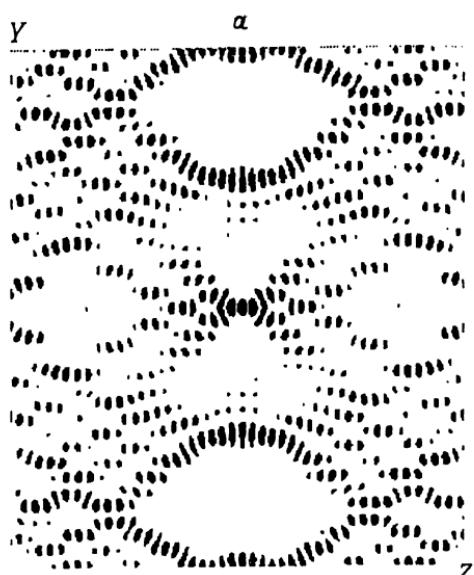
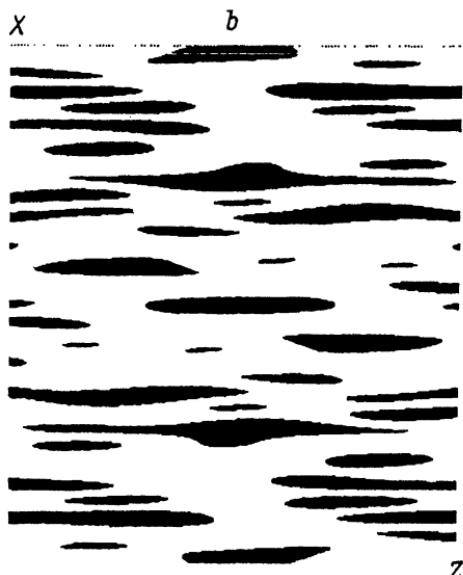


Рис. 4. Расчетное распределение интенсивности при взаимодействии 11 лучей.

рассеянного светового пучка на плоскость XZ и осью Z ; рис. 5). Индуцированные центры рассеяния представим в виде цилиндров с Δn , зависящим только от ориентации цилиндра. Будем рассматривать цилиндры, расположенные параллельно плоскости XZ . Так, ориентированные цилиндры имеют наибольшее сечение рассеяния для основного пучка. Введем $\rho(y, \varphi')$ — распределение фотоиндуцированных центров (φ' — угол между осью X и осью цилиндра). Входную грань кристалла поместим в $y = 0$, y_0 обозначим толщину кристалла. Изменение распределения рассеяния при прохождении толщины dy определяется двумя факторами: голограммическим усилением η (оно при описании рассеяния фиксированными по интенсивности пучками выражается изменением количества пучков, идущих в заданном направлении) и

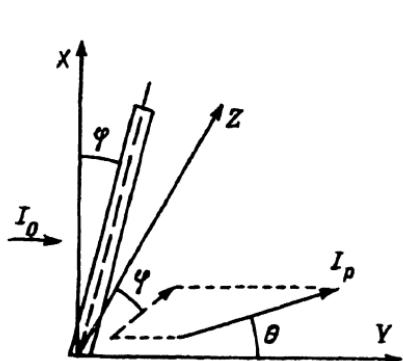


Рис. 5. Иллюстрация расположения цилиндрической неоднородности и направлений облучения I_0 и рассеяния I_p .

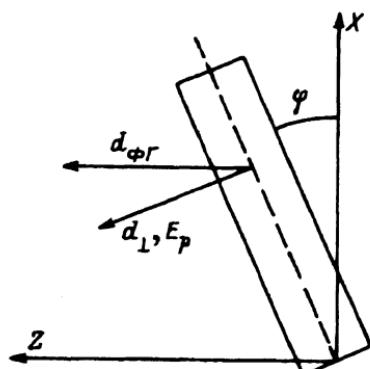


Рис. 6. Иллюстрация расположения неоднородностей и направлений фотогальванических токов и электрических полей.

рождением пучков V на центрах рассеяния

$$\frac{dN(y, \theta, \varphi)}{dy} = V(y, \theta, \varphi) + \eta(y, \theta, \varphi). \quad (1)$$

На цилиндре, ориентированном под углом φ' , основной пучок, рассеиваясь, должен дать пучки рассеяния $N(y, \theta, \varphi)$ с $\varphi = \varphi'$ (формально считаем, что в $\rho(y, \varphi')$ φ' меняется от 0 до 2π). Учтем, что в соответствии с формулой Френеля рассеяние на неоднородности пропорционально $\Delta n_p^2(\varphi)$. Введем $\omega(\theta)$ — зависимость интенсивности рассеяния на индуцированном центре от угла между основным и рассеянным лучами. Будем учитывать только фотоиндуцированные неоднородности Δn . Тогда

$$V(y, \theta, \varphi) \sim \rho(y, \varphi) \Delta n_p^2(\varphi) \omega(\theta) I_0, \quad (2)$$

где I_0 — интенсивность основного пучка.

Распределение $\rho(y, \varphi)$ образуется в результате многолучевой интерференции пучков рассеяния, расположенных в плоскости, образующей угол φ с осью Z . Эту связь мы выразим в виде

$$\rho(y, \varphi) \sim \int_0^\pi N(y, \theta, \varphi) d\theta, \quad (3)$$

η может быть записана как

$$\eta(y, \theta, \varphi) \sim \Delta n_g(\theta, \varphi) N(y, \theta, \varphi) I_0, \quad (4)$$

где $\Delta n_g(\theta, \varphi)$ характеризует запись голограммы пучком с интенсивностью i , распространяющимся в направлении (θ, φ) .

Изменением интенсивности основного пучка пренебрежем, поскольку мы выясняем только относительное угловое распределение рассеяния. В таком случае получаем

$$\frac{dN(y, \theta, \varphi)}{dy} = \beta_1 \Delta n_p^2(\varphi) \omega(\theta) \int_0^\pi N(y, \theta', \varphi) d\theta' + \beta_2 \Delta n_g(\theta, \varphi) N(y, \theta, \varphi), \quad (5)$$

где β_1, β_2 — некоторые коэффициенты.

Известно, что Δn в LiNbO_3 пропорционально наведенному фотогальваническим током, текущим вдоль z , электрическому полю. В плоской или цилиндрической освещенной области фотогальванический ток можно представить в виде двух составляющих — продольной и поперечной. Для рассматриваемой задачи важной является поперечная составляющая электрического поля. Для цилиндрической области, согласно рис. 6, можно записать

$$E_{pz} = \alpha_1 \cos^2 \varphi, \quad E_{px} = \alpha_1 \sin \varphi \cos \varphi, \quad (6)$$

где α_1 — некоторый коэффициент.

Аналогично можно вычислить составляющие электрического поля для штрихов голограммической решетки, записываемой основным лучом и рассеянным в направлении (θ, φ)

$$E_{gz} = \alpha_2 \cos^2(\theta/2) \cos^2 \varphi, \quad E_{gx} = \alpha_2 \cos^2(\theta/2) \cos \varphi \sin \varphi. \quad (7)$$

Учитывая, что рассеяние происходит в небольшие углы (угол полного внутреннего отражения $\sim 26^\circ$), положим в (7) $\cos^2 \theta/2 \approx 1$. Тогда решение уравнения (5) можно записать в виде

$$N(y, \theta, \varphi) = I(y, \varphi) \omega(\theta),$$

где $I(y, \varphi)$ отвечает уравнению

$$\frac{dI(y, \varphi)}{dy} = \beta_3 [\Delta n(\mathbf{E}_p(\varphi))]^2 I(y, \varphi) + \beta_2 \Delta n(\mathbf{E}_g(\varphi)) I(y, \varphi). \quad (8)$$

Решение (8) зависит от распределения $I(0, \varphi)$ на входе в кристалл. Согласно представлениям, изложенным в [2], на $I(0, \varphi)$ оказывает влияние свет, отраженный от граней кристалла и окружающих его предметов. В результате этого образуется обратная связь: неоднородное, меняющееся во времени, распределение интенсивности, созданное происходящими в объеме процессами, передается в распределение, действующее на входе. Обратная связь может внести дополнительную анизотропию: например, свет, отраженный от выходной, а затем от входной грани, дополняет $I(0, \varphi)$ распределением, имеющимся на выходе. Однако последовательное рассмотрение этого случая требует учета в уравнениях изменения интенсивности основного пучка и поэтому здесь рассматриваться не будет. Будем полагать, что на входе распределение рассеяния изотропно, и тем самым определим роль внутренних факторов. При таком предположении решение (8) принимает вид

$$I(y, \varphi) = I(0) \exp \left\{ [\beta_3 [\Delta n(\mathbf{E}(\varphi))]^2 + \beta_2 \Delta n(\mathbf{E}_g(\varphi))] y \right\}. \quad (9)$$

Рассматривая (9) для случая, когда основной пучок является необыкновенным, т.е.

$$\Delta n(\mathbf{E}) = r_{33} E_z, \quad (10)$$

получим зависимость от угла φ , которая максимальна при $\varphi = 0$, что соответствует рассеянию, вытянутому вдоль Z

$$I(\varphi) \sim e^{(\gamma \cos^4 \varphi + g \cos^2 \varphi)}, \quad (11)$$

где γ, g — коэффициенты. Второе слагаемое в показателе экспоненты описывает влияние голограммического усиления; из сравнения с описанным в работе экспериментом $g \sim 2$. Отнормированная зависимость (11) при $g = 2$ и $\gamma = 4$ представлена на рис. 2 сплошной линией.

В случае обыкновенного основного пучка

$$\Delta n \sim r_{22} \cos \varphi \sin \varphi + r_{13} \cos^2 \varphi$$

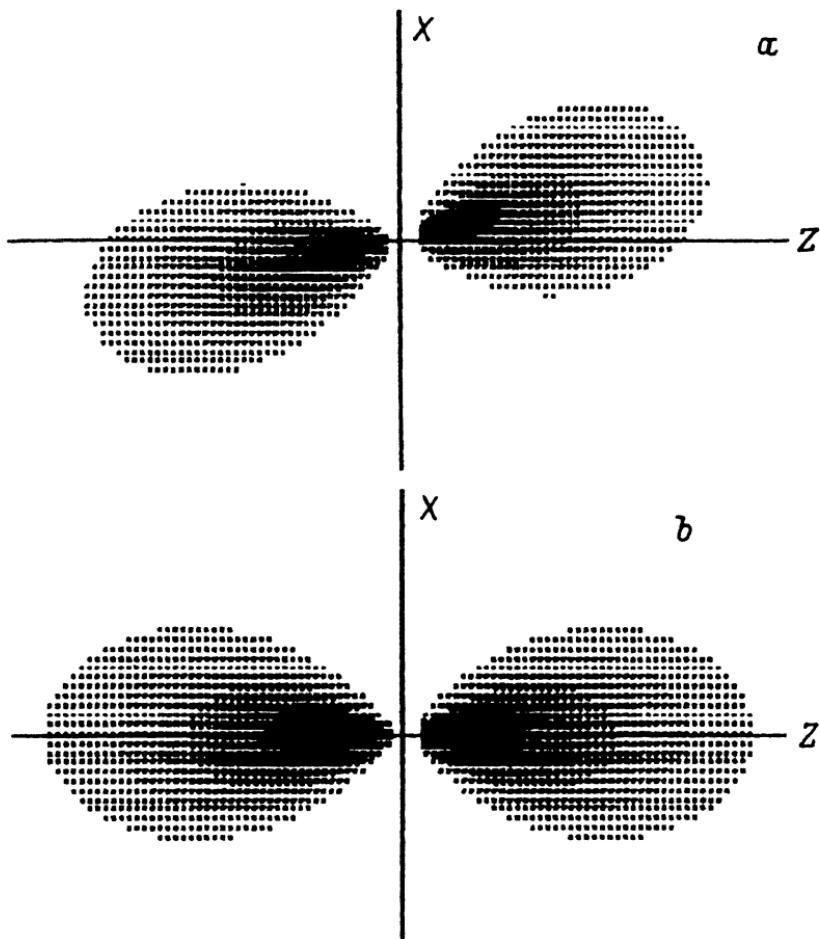


Рис. 7. Расчетное распределение рассеяний $e-e(\parallel Z)$ (а) и $o-o(\parallel Z)$ (б).

решение (11) имеет тот же вид с заменой $\cos^2 \varphi$ на $r_{22} \cos \varphi \sin \varphi + r_{13} \cos^2 \varphi$. В этом случае легко вычислить, что максимальное рассеяние для LiNbO_3 ($r_{22}/r_{13} = 0.4$) достигается при $\varphi = 11^\circ$, что хорошо совпадает с экспериментом.

Был сделан численный расчет распределения интенсивности рассеяния (рис. 7). При этом учитывалось, что разные пучки рассеяния имеют разную длину взаимодействия с основным пучком. Она ограничена из-за конечных размеров сечения основного пучка.

В заключение подчеркнем, что в литературе внимание в основном уделено объяснению менее интенсивных рассеяний, проявляющихся в более специфических условиях по сравнению с $o-o(\parallel Z)$ и $e-e(\parallel Z)$. Последние не согласуются с идеями модели стационарного голографического усиления исходного фона рассеяния. В динамической модели, как мы видим, эти виды рассеяния (и др. [2]) находят объяснение. Предположения, делаемые в этой модели, подтверждаются опытными данными, а расчетные характеристики рассеяния соответствуют экспериментальным зависимостям.

Авторы благодарят Международный благотворительный фонд «Культурная инициатива» (Фонд Сороса) за частичную финансовую поддержку работы.

Список литературы

- [1] Винецкий В.Л., Кухтарев Н.В., Одолов С.Г., Соскин М.С. // УФН. 1979. Т. 129. № 1. С. 113–137.
- [2] Канаев И.Ф., Малиновский В.К. // Автометрия. 1991. № 4. С. 37–48.
- [3] Канаев И.Ф., Малиновский В.К. // ФТТ. 1992. № 8. С. 2529–2537.
- [4] Хатьков Н.Д., Шандаров С.М. // Автометрия. 1983. № 2. С. 61–64.

Институт автоматики
и электрометрии СО РАН
Новосибирск

Поступило в Редакцию
31 марта 1993 г.
В окончательной редакции
20 октября 1993 г.
